

# OBMOČJE HOMOGENOSTI TETRAGONALNEGA $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$

## THE HOMOGENEITY RANGE OF TETRAGONAL $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$

Urša Pirnat, Matjaž Valant, Danilo Suvorov

Institut "Jožef Stefan", Odsek za sodobne materiale, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija  
ursa.pirnat@ijs.si

Prejem rokopisa – received: 2003-02-13; sprejem za objavo – accepted for publication: 2004-03-26

S kombinacijo različnih analiznih metod (merjenje dielektričnih lastnosti, rentgenska praškovna difrakcija in mikrostrukturalna analiza) smo določili meje območja homogenosti tetragonalne spojine  $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$ . Območje homogenosti se nahaja med molskim deležem  $\text{Nb}_2\text{O}_5$  25 % in 26 %. V tem območju so vzorci enofazni s kristalno strukturo tetragonalnega  $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$ . Po preseženi trdnosti topnosti se začenjajo pojavljati vključki ferroelektrične faze  $\text{Bi}_5\text{Nb}_3\text{O}_{15}$ . V tem območju homogenosti ostaja dielektričnost približno 90, temperaturni koeficient rezonančne frekvence  $110 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ , dielektrične izgube se z večanjem koncentracije  $\text{Nb}_2\text{O}_5$  manjšajo. Ko presežemo območje homogenosti, dielektrične izgube zelo narastejo, kar je posledica ferroelektrične faze  $\text{Bi}_5\text{Nb}_3\text{O}_{15}$ . Rezultati omenjenih raziskav kot tudi raziskave kemijske in procesne kompatibilnosti s tehnologijo nizkotemperaturne sočasno sintrane keramike (LTCC) so potrdili, da je keramika na osnovi  $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$  v območju homogenosti uporabna za visokodielektrične plasti v mikrovalovnih elektronskih LTCC-modulih.

Ključne besede: bizmutov niobat, območje homogenosti, dielektrične lastnosti, LTCC

The boundaries of the homogeneity range of tetragonal  $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$  were determined by the combination of different analytical techniques (dielectric properties analysis, X-ray powder diffraction and microstructure analysis). The homogeneity range was found to be between 25–26 % molar fractions of  $\text{Nb}_2\text{O}_5$ . Within that range the samples are single phase with a tetragonal crystal structure. A ferroelectric  $\text{Bi}_5\text{Nb}_3\text{O}_{15}$  phase appears when the solid solubility of  $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$  is exceeded. Within the homogeneity range the dielectric constant remains approximately 90 and the temperature coefficient of resonant frequency  $110 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ . The dielectric losses continuously decrease with increasing amounts of  $\text{Nb}_2\text{O}_5$ . Above the solubility range the dielectric losses significantly increase as a consequence of the presence of the ferroelectric  $\text{Bi}_5\text{Nb}_3\text{O}_{15}$  phase. The results described in this presentation and the research of chemical and process compatibilities with low-temperature co-fired ceramic (LTCC) technology confirmed that ceramics from this homogeneity range are useful for high-dielectric layers in microwaves electronic LTCC modules.

Key words: bismuth niobate, homogeneity range, dielectric properties, LTCC

## 1 UVOD

$\delta\text{-Bi}_2\text{O}_3$  je kubična visokotemperaturna modifikacija  $\text{Bi}_2\text{O}_3$  s fluoritno strukturo, ki je obstojna od 730 °C do tališča pri 825 °C.<sup>1</sup> Osnovna celica je ploskovno centrirana kocka, kjer ogljiča in sredino ploskev zasedajo bizmutovi ioni, kisikova podmreža pa je 75-odstotno zasedena.

Intenzivne raziskave trdnih raztopin z  $\delta\text{-Bi}_2\text{O}_3$  so se začele zaradi visoke ionske prevodnosti teh materialov,<sup>2,3</sup> ki so zaradi te lastnosti primerni kot trdni elektroliti za membrane, gorilne celice in senzorje.<sup>3,4</sup> Kot poročata Tanaka in Miida<sup>5</sup> se z dopiranjem  $\delta\text{-Bi}_2\text{O}_3$  s petvalentnimi oksidi (kot naprimjer  $\text{V}_2\text{O}_5$ ,  $\text{Nb}_2\text{O}_5$  in  $\text{Ta}_2\text{O}_5$ ) temperaturno območje stabilnosti modifikacije razširi tako, da je  $\delta$ -modifikacija stabilna tudi pri sobni temperaturi. Zaradi zelo visoke ionske prevodnosti trdnih raztopin na osnovi  $\delta\text{-Bi}_2\text{O}_3$  –  $\text{Nb}_2\text{O}_5$  ( $\delta\text{-BN}_{\text{SS}}$ ) je bilo v sistemu  $\text{Bi}_2\text{O}_3$  –  $\text{Nb}_2\text{O}_5$  do sedaj opravljenih več kristalografskih raziskav in raziskav faznih ravnotežij. V novejših člankih avtorji poročajo, da se območje  $\delta\text{-BN}_{\text{SS}}$  razteza do molskega deleža  $\text{Nb}_2\text{O}_5$  25 %.<sup>6</sup> Nasprotno so pri raziskavah stabilnosti  $\delta\text{-BN}_{\text{SS}}$  pri sestavi z molskim deležem  $\text{Nb}_2\text{O}_5$  25 % poleg kubične modifikacije

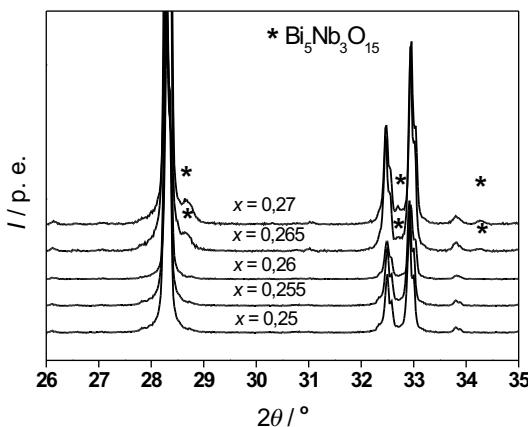
sintetizirali tudi tetragonalno modifikacijo  $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$ .<sup>7,8</sup> Na osnovi rezultatov kristalografske študije so avtorji prvič poročali o obstoju enofazne tetragonalne modifikacije  $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$ .<sup>9</sup> Več o pogojih tvorbe tetragonalne spojine  $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$  in njenih lastnostih pa poročajo Valant et al.<sup>10</sup> V sistemu  $\text{Bi}_2\text{O}_3$  –  $\text{Nb}_2\text{O}_5$  se v ozkem temperaturnem območju od 850 °C do 880 °C tvori tetragonalna spojina  $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$ . Tetragonalna spojina  $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$  ima dielektrično konstanto 90, temperaturni koeficient rezonančne frekvence  $110 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$  in v primerjavi z  $\delta\text{-BN}_{\text{SS}}$  manjše dielektrične izgube ( $Q \times f = 730 \text{ GHz}$ ).

Tehnologija nizkotemperaturno sočasno sintrane keramike (Low-temperature cofired-ceramics – (LTCC)) je tehnologija izdelave elektronskih komponent, kjer se z zlaganjem različnih funkcionalnih keramičnih plasti z natisnjениm mikrovalovnim vezjem združijo pasivne elektronske komponente v trodimenzionalni modul. S tem je omogočena integracija, miniaturizacija, večja ekonomičnost in uporabnost elektronskih komponent. Tudi tetragonalna spojina  $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$  kaže lastnosti, kot so nizka temperatura sintranja, termodinamska kompatibilnost s srebrom, visoka dielektrična konstanta in nizke dielektrične izgube in je zato potencialna kandidatka za keramično plast v LTCC tehnologiji.<sup>10</sup> Spojina je še

razmeroma malo raziskana, zato je treba na osnovi raziskav faznih ravnotežij in pogojev procesiranja optimizirati dielektrične lastnosti. V našem laboratoriju smo izvedli sintezo in na osnovi rezultatov rentgenske praškovne difrakcije ugotovili, da v okolini tetragonalne spojine  $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$  obstaja območje homogenosti. Cilj te raziskave je določiti koncentracijsko območje homogenosti, definirati območje termične stabilnosti in določiti dielektrične lastnosti. Nadalje je cilj raziskav tudi določitev optimalne sestave in pogojev procesiranja materialov iz območja homogenosti za uporabo v LTCC-modulih.

## 2 EKSPERIMENTALNI DEL

Z reakcijo v trdnem stanju smo pripravili sestave ( $1 - x$ )  $\text{Bi}_2\text{O}_3 : x \text{Nb}_2\text{O}_5$  v območju  $0,25 \leq x \leq 0,27$ . Stehiometrične mešanice suhih reaktantov ( $\text{Bi}_2\text{O}_3$ , 99,975 %, Alfa Aesar in  $\text{Nb}_2\text{O}_5$ , 99,99+ %, Alfa Aesar) smo homogenizirali v ahatni tarilnici, stisnili v tablete in segrevali 10 h pri 700 °C. Med segrevanjem  $\text{Bi}_2\text{O}_3$  reagira z  $\text{Nb}_2\text{O}_5$  v kubični bizmutov niobat, ki ga lahko segrevamo pri višji temperaturi, brez znatnih izgub  $\text{Bi}_2\text{O}_3$ . Proces kalcinacije smo ponovili pri 750 °C. Po njej smo zdobjavljen kalciniran prah stisnili enoosno s tlakom 100 MPa in ga žgali 5 h pri temperaturah od 800 °C do 950 °C. Razpad visokotemperатурne faze je počasen proces, zato vzorcev ni bilo treba kaliti in so se ohlajali s približno hitrostjo 15 °C/min. Tako pripravljene vzorce smo zdobili in prah uporabili za raziskave faz z rentgensko praškovno analizo. Z Brukerjevim difraktometrom AXS D4 Endeavor s svetlobo  $\text{Cu K}_\alpha$  smo snemali v območju  $2\theta$  od 10° do 70°. Pri tem je bil stopenjski korak 0,02° in čas detekcije 2 s na stopenjski korak. Uporabili smo variabilne reže V6. Za mikrovalovne dielektrične meritve smo uporabili mrežni analizator HP 8719C. Merili smo v zaprtem votlinskem rezonatorju, kjer smo z refleksijskim načinom meritve iz rodu TE<sub>018</sub> po Kajfeževi metodi<sup>11</sup> izračunali dielektrično



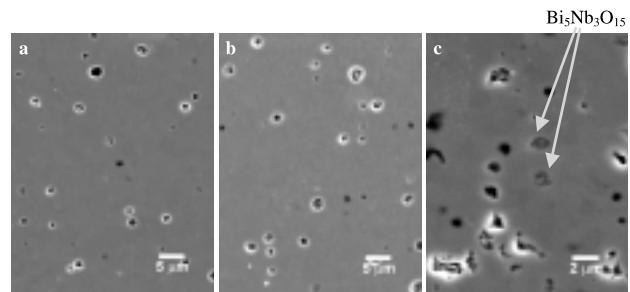
Slika 1: Rentgenski difrakcijski spektri vzorcev na osnovi ( $1 - x$ )  $\text{Bi}_2\text{O}_3 : x\text{Nb}_2\text{O}_5$  s sestavo  $0,25 \leq x \leq 0,27$ , žgani pri 880 °C

Figure 1: X-ray diffraction pattern of ( $1 - x$ )  $\text{Bi}_2\text{O}_3 : x\text{Nb}_2\text{O}_5$  samples for  $0,25 \leq x \leq 0,27$ , sintered at 880 °C

konstanto in dielektrične izgube (vrednost  $Q \times f$ ). Z vrstičnim elektronskim mikroskopom (SEM) JEOL 5600, ki je opremljen s programsko opremo LINK ISIS, smo pregledali spolirane in kemijsko pojedkane vzorce, pri čemer smo identiteto posameznih faz določili z energijsko disperzijsko spektroskopijo (EDS). Na osnovi posnetka SEM smo kasneje stereološko določili velikost zrn. Poroznost smo določili po Arhimedovem principu vzgona.

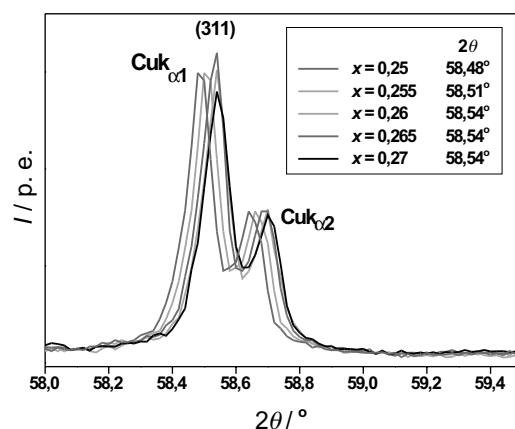
## 3 REZULTATI IN DISKUSIJA

Rentgenska difrakcijska analiza sestav  $0,25 \leq x \leq 0,27$  (slika 1), sintetiziranih pri 880 °C, je pokazala prisotnost samo tetragonalne flouritne modifikacije, ki je lastna  $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$  (t. i. tip III)<sup>9</sup>. Ko presežemo  $x = 0,26$  se poleg tetragonalne faze pojavi v vzrocih tudi ferolektrična spojina  $\text{Bi}_5\text{Nb}_3\text{O}_{15}$ , kar je v soglasju s faznim diagramom.<sup>9</sup> Tudi SEM-raziskave mikrostruktur (sliki 2a in 2b) so pokazale, da je sistem do  $x = 0,26$  enofazen, v keramiki z  $x > 0,26$  (slika 2c) pa se pojavijo vključki



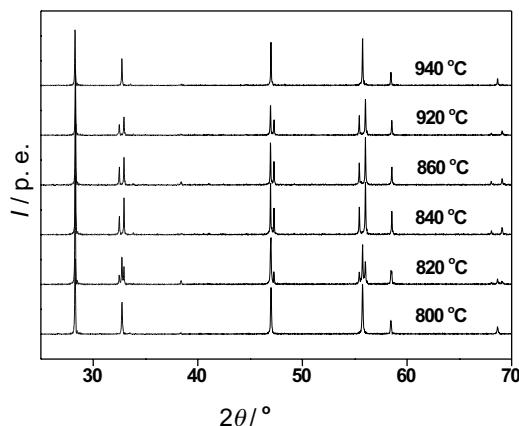
Slika 2: SEM-posnetki mikrostruktur keramike s sestavo ( $1 - x$ )  $\text{Bi}_2\text{O}_3 : x\text{Nb}_2\text{O}_5$  z a)  $x = 0,255$ , b)  $x = 0,26$  in c)  $x = 0,265$ ; temperatura sintranja je bila 880 °C

Figure 2: Microstructures of ( $1 - x$ )  $\text{Bi}_2\text{O}_3 : x\text{Nb}_2\text{O}_5$  ceramics with a)  $x = 0,255$ , b)  $x = 0,26$  and c)  $x = 0,265$ , sintered at 880 °C



Slika 3: Premik uklonskega kota [311] tetragonalne faze  $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$  v odvisnosti od nominalne sestave v območju sestav  $0,25 \leq x \leq 0,27$ . Vzorci so bili žgani pri 880 °C.

Figure 3: Shift of the diffraction line [311] of tetragonal  $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$  phase for the nominal composition in the range  $0,25 \leq x \leq 0,27$ . Samples were sintered at 880 °C.



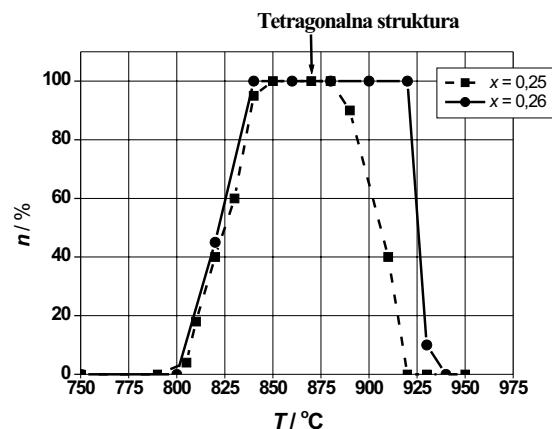
**Slika 4:** Rentgenski praškovni difraktogrami vzorcev s sestavo  $x = 0,26$  v odvisnosti od temperature sinteze prikazujejo fazno pretvorbo iz nizkotemperaturne kubične v tetragonalno in naprej v visokotemperaturno kubično modifikacijo

**Figure 4:** X-ray diffraction patterns of samples with composition  $x = 0.26$  as a function of synthesis temperature where phase transformation is presented from low-temperature cubic into tetragonal and further into the high-temperature cubic transformation

$\text{Bi}_5\text{Nb}_3\text{O}_{15}$ . EDS-analiza vzorcev s sestavami  $x \leq 0,26$  je pokazala, da v enofaznih vzorcih narašča koncentracija Nb in pada koncentracija Bi, pri vzorcih  $x > 0,26$  obe koncentraciji ostajata konstantni. Ti rezultati kažejo da, obstaja trdna topnost v območju  $0,25 \leq x \geq 0,26$ , kar smo dodatno potrdili tudi z opazovanjem premika difrakcijskega [311] uklona tetragonalne  $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$  faze za različno nominalno sestavo (slika 3). Uklonski kot se z večanjem vsebnosti  $\text{Nb}_2\text{O}_5$  pomika k višjim kotom. Ta premik se pojavlja do sestave  $x = 0,26$ , nato pa položaj tega uklonskega kota z nadaljnjam večanjem vsebnosti  $\text{Nb}_2\text{O}_5$  ostaja enak. Opisane analize potrjujejo obstoj homogenosti trdne raztopine na osnovi tetragonalne spojine  $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$  v območju molskih deležev  $\text{Nb}_2\text{O}_5$  od 25 % do 26 %. Predložena formula trdne raztopine je  $\text{Bi}_{3-y}\text{Nb}_{1+y}\text{O}_{7+y}$ , kjer je  $0 \leq y \leq 0,04$ .

Pri določevanju termične stabilnosti tetragonalnega  $\text{Bi}_{3-y}\text{Nb}_{1+y}\text{O}_{7+y}$ , smo opazovali fazne pretvorbe iz nizkotemperaturne kubične v tetragonalno in naprej v visokotemperaturno kubično modifikacijo. Za sestavo  $x = 0,26$  smo na sliki 4 prikazali rentgenske praškovne difraktofreme vzorcev, ki so bili žgani 5 h pri različnih temperaturah v intervalu od 800 °C do 940 °C. Pri najnižji temperaturi žganja 800 °C se tvori kubična struktura  $\delta\text{-Bi}_2\text{O}_3$ , nato se z višanjem temperature začnejo pojavljati ukloni, ki so značilni za tetragonalno strukturo  $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$ . Vsebnost tetragonalne faze narašča z višanjem temperature, dokler pri 840 °C transformacija ni popolna. Enofazna tetragonalna modifikacija se tvori v temperaturnem območju od 840 °C do 920 °C. Nato pa se zopet tvori faza s kubično  $\delta\text{-Bi}_2\text{O}_3$ -strukturo ( $\delta\text{-BN}_{ss}$ ).

Fazni deleži tetragonalne modifikacije v odvisnosti od temperature sinteze za sestavi  $x = 0,25$  in  $x = 0,26$  so prikazani na sliki 5. Fazni deleži so izračunani iz intenzitet uklonov tetragonalne in kubične modifikacije.

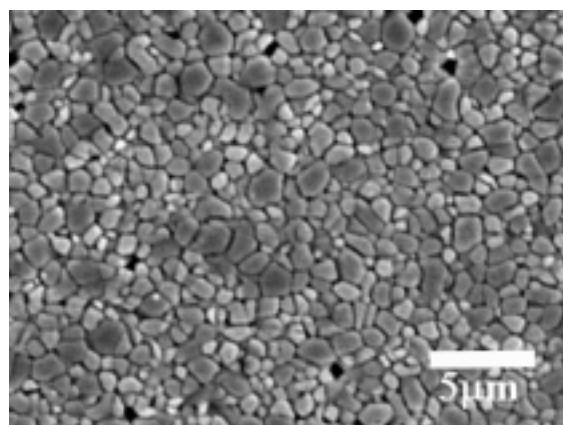


**Slika 5:** Fazni deleži  $n$  tetragonalne modifikacije (izračunani iz intenzitet uklonov rentgenskih praškovnih difraktogramov) za sestavi:  $x = 0,25$  in  $x = 0,26$  v odvisnosti od temperature sinteze

**Figure 5:** Phase fraction of the tetragonal modification (calculated from the intensities of x-ray powder diffraction) for compositions:  $x = 0.25$  and  $x = 0.26$  as a function of synthesis temperature

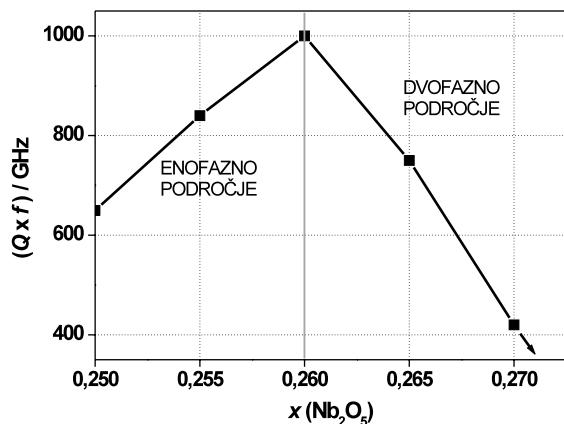
Tetragonalna spojina  $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$  oziroma sestava z molskim deležem  $\text{Nb}_2\text{O}_5$  25 % je stabilna v temperaturnem intervalu 30 °C (850–880 °C), medtem ko je sestava s 26 %  $\text{Nb}_2\text{O}_5$  stabilna v temperaturnem intervalu 80 °C (840–920 °C). Temperaturna stabilnost območja homogenosti tetragonalnega  $\text{Bi}_{3-y}\text{Nb}_{1+y}\text{O}_{7+y}$  ( $0 \leq y \leq 0,04$ ), se torej veča z višanjem koncentracije  $\text{Nb}_2\text{O}_5$ .

Tipična mikrostruktura vzorcev, sintranih 5 h pri 880 °C, pri katerih smo določili mikrovalovne lastnosti (MW), je prikazana na sliki 6. Vzorci so gosto sintarani s teoretično gostoto  $> 97\%$ . V mikrostrukturi ni zaznati tekoče faze. Povprečna velikost delcev je bila določena stereološko na 1,5  $\mu\text{m}$ . Dielektrična konstanta, izmerjena pri 4 GHz, se v območju homogenosti bistveno ne spreminja in je  $\approx 90$ . V vsem koncentracijskem območju je konstanten tudi temperaturni koeficient resonančne frekvence, ki ima vrednost  $\approx 110 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ . Pač pa se z naraščanjem koncentracije  $\text{Nb}_2\text{O}_5$  zmanjšujejo dielek-



**Slika 6:** SEM-posnetek mikrostrukture kemijsko jedkanega vzorca s sestavo  $x = 0,25$ , sintarnega 5 h pri 880 °C

**Figure 6:** Microstructure of chemically etched sample with composition  $x = 0.25$ , sintered for 5 h at 880 °C



Slika 7: Vrednost  $Q \times f$  (merjeno pri 4 GHz) vzorcev z nominalno sestavo  $0,25 \leq x \leq 0,27$ , sintaranih pri  $880^\circ\text{C}$

Figure 7:  $Q \times f$  values (measured at 4 GHz) of samples with nominal  $0,25 \leq x \leq 0,27$ , sintered at  $880^\circ\text{C}$

trične izgube oziroma se viša njihova recipročna količina – vrednost  $Q \times f$  (slika 7). Vzorec s sestavo  $x = 0,25$  ima vrednost  $Q \times f$  730 GHz, pri višji koncentraciji  $\text{Nb}_2\text{O}_5$  pri sestavi  $x = 0,26$ , pa ta vrednost naraste na 1000 GHz. Ko presežemo molsko koncentracijo  $\text{Nb}_2\text{O}_5$  26 %, pa feroelektrična faza  $\text{Bi}_5\text{Nb}_3\text{O}_{15}$  z visokimi dielektričnimi izgubami povzroči, da se vrednosti  $Q \times f$  bistveno zmanjšajo.

Rezultati študije so pokazali, da je za LTCC-aplikacije najbolj primerna tetragonalna modifikacija ( $1 - x$ )  $\text{Bi}_2\text{O}_3 : x \text{Nb}_2\text{O}_5$  s sestavo  $x = 0,26$ .

#### 4 SKLEPI

Območje homogenosti tetragonalnega  $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$  je omejeno na eni strani s spojino  $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$  (25 %  $\text{Nb}_2\text{O}_5$ ) na drugi strani pa s sestavo s 26 %  $\text{Nb}_2\text{O}_5$ . Trdno

raztopino lahko opišemo s formulo  $\text{Bi}_{3-y}\text{Nb}_{1+y}\text{O}_{7+y}$ , ( $0 \leq y \leq 0,04$ ). Termična stabilnost trdne raztopine se veča z večanjem koncentracije  $\text{Nb}_2\text{O}_5$  saj je pri sestavi  $x = 0,25$  temperaturni interval stabilnosti  $30^\circ\text{C}$ , pri  $x = 0,26$  pa se poveča na  $90^\circ\text{C}$ . Tetragonalna spojina  $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$  ima visoko dielektrično konstanto (90), pozitiven temperaturni koeficient resonančne frekvence ( $110 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ ), nizko vrednost  $Q \times f$  (730 GHz). Z višanjem koncentracije  $\text{Nb}_2\text{O}_5$  se dielektričnost in temperaturni koeficient resonančne frekvence bistveno ne spremenita, vrednost  $Q \times f$  pa se zviša do 1000 GHz. Ker je keramika termodinamsko kompatibilna s srebrom in ima temperaturo sintranja nižjo od  $900^\circ\text{C}$ , lahko sklepamo, da je keramika na osnovi tetragonalnega  $\text{Bi}_3\text{NbO}_7$  uporabna za visokodielektrične plasti v LTCC-modulih.

#### 5 LITERATURA

- <sup>1</sup>R. S. Roth, J. L. Waring, *J. Res. Natl Bur. Stand., Sect A*, 66A (1962) 6, 451–463
- <sup>2</sup>T. Takahashi, H. Iwahara, *Mater. Res. Bull.*, 13 (1978) 12, 1447–1453
- <sup>3</sup>A. A. Yaremchenko, V. V. Kharton, E. N. Naumovich, A. A. Vecher, *J. Solid State Electrochem.*, 2 (1998) 3, 146–149
- <sup>4</sup>E. D. Wachman, P. Jayaweera, N. Jiang, D. M. Lowe, G. G. Pound, *J. Electchem. Soc.*, 144 (1997) 1, 233–236
- <sup>5</sup>R. Miida, M. Tanaka, *Jpn. J. Appl. Phys. Part 1*, 29 (1990) 6, 1132–1138
- <sup>6</sup>C. D. Ling, R. L. Withers, S. Schmid, J. G. Thompson, *J. Solid State Chem.*, 137 (1998) 1, 42–61
- <sup>7</sup>A. Castro, Eaguado, J. M. Rojo, P. Herrero, R. Enjalbert, J. Galy, *Mater. Res. Bull.*, 33 (1998) 1, 31–41
- <sup>8</sup>W. Zhou, D. A. Jefferson, J. M. Thomas, *J. Solid State Chem.*, 70 (1987) 1, 129–136
- <sup>9</sup>C. D. Ling, *J. Solid State Chem.*, 148 (1999), 380–405
- <sup>10</sup>M. Valant, D. Suvorov, *J. American Ceramic Society*, 86 (2003) 6, 939–44
- <sup>11</sup>D. Kajfez, E. J. Hwan, *IEEE Trans. MTT*, 32 (1984), 666–670